

Неъматов Махсудшо Гайратович

**Разработка методов модификации магнитомеханических свойств аморфных
микропроводов для построения высокочувствительных миниатюрных датчиков
механических напряжений**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Специальность **05.27.06** – «Технология и оборудование для производства
полупроводников, материалов и приборов электронной техники»

Работа выполнена на кафедре «Технологии материалов электроники» федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор, ведущий научный сотрудник кафедры Технологии Материалов Электроники федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Панина Лариса Владимировна.

Экспертная комиссия:

1. Калошкин Сергей Дмитриевич, профессор, доктор физико-математических наук, директор Института новых материалов и нанотехнологий НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;
2. Лилеев Алексей Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физического материаловедения НИТУ «МИСиС»;
3. Ховайло Владимир Васильевич, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС»;
4. Перов Николай Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры магнетизма федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»;
5. Розанов Константин Николаевич, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской академии наук» (ИТПЭ РАН).

Ведущее предприятие:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

Защита диссертации состоится «20» декабря 2019 года по адресу 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 4